

中山大学本科生期中考试-答案

考试科目：《固体物理》（A 卷）

学年学期：2016 学年第 1 学期 姓 名： _____
学 院/系：物理学院 学 号： _____
考试方式：半开卷（手写备忘 1 张 A4 纸） 年级专业： 14 级 光信息
考试时长：100 分钟 班 别： _____
任课老师：钟定永

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 2 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、名词解释（共 30 分）

1、基元，威格纳-赛兹原胞，布拉菲格子；

基元：晶体结构的最小重复单元，具有物理内涵，可以是原子或原子团。

威格纳-赛兹原胞：能反映晶体对称性的最小重复单元。

布拉菲格子：挑选各基元中的任一点，把最近邻的这一点相连，抽象出的三维几何网络。

2、声子，声学声子，光学声子；

声子：是一种准粒子，是晶体原子集体运动形成的格波的能量激发单元。

声学声子：原胞含有不止一个原子的晶体振动的声学支格波的能量量子。

光学声子：原胞含有不止一个原子的晶体振动的声学支格波的能量量子。

3、Hartree-Fock近似（单电子近似），Bloch（布洛赫）定理，波恩-卡门条件，能隙。

单电子近似：

布洛赫定理：

波恩-卡门条件：

能隙：

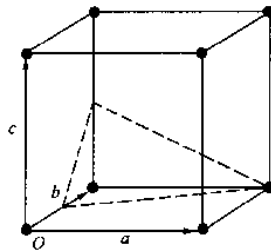
二、判断题（共 20 分）

1. 常温常压下，NaCl晶体和金刚石都具有面心立方结构。（对）
2. 具有平移对称性的晶体结构不存在5重旋转对称轴。（对）
3. 提高温度晶体可以产生声子。（对）
4. 金属结合具有饱和性和方向性。（错）
5. 近自由电子模型的能带结构：能隙出现在布里渊区的中心（ $k=0$ ）处。（错）
6. 每个布里渊区的体积均相等，都等于倒格子原胞的体积。（对）
7. 晶格振动波矢的总数等于晶体的原胞数。（对）
8. 等体积硬球堆积成体心立方和面心立方结构，体心立方结构致密度大于面心立方。（错）
9. 格波的色散关系只能在第一布里渊区表示才有物理意义。（对）

10. 在非常低的温度下，短波声子比长波声子更容易被热激发，对热容量有主要贡献。
(错)
11. 三维晶体电子的等能面是一系列的封闭曲面。(错)
12. 高温下，热导率K与温度T成正比。(错)
13. 表面电子态局限在晶体的表面处，不具有布洛赫函数的形式。(错)
14. 参与U过程的主要是短波声子。(对)
15. 非晶固体内的电子也有可能处于扩展态。(对)
16. 原子的排列具有周期性才能形成能带。(错)
17. 面心立方格子的倒格子是体心立方，体心立方格子的倒格子是面心立方。(对)
18. 在声子与晶格的相互作用过程中，声子数必须守恒。(错)
19. 晶体的单电子哈密顿算符与相应的点群操作算符对易。(对)
20. 用紧束缚近似处理晶体能带结构：相邻原子的轨道波函数重叠越多，所形成的能带就越宽。(对)

三、选择题 (共 8 分)

1. 钛酸钙（钙钛矿）结构属于 (A)
A. 简单立方； B. 体心立方； C. 底心单斜； D. 面心立方； E. 六角密堆积
2. 低温下，金属晶格的比热随温度的变化规律正比于 (D)
A. T^0 B. T^1 C. T^2 D. T^3 E. $e^{-E/kT}$
3. 黄昆方程是 (B)
A. $\vec{W} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$; B. $\vec{W} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$; C. $\vec{W} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$;
 $\vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E}$; $\vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E}$; $\vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E}$;
D. $\vec{W} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$; E. $\vec{W} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$
 $\vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E}$; $\vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E}$
4. 一立方晶系的晶格常数为 a ，如下图所示平面的晶面指数为 (C)



- A. $(\bar{1}12)$; B. (021) ; C. $(\bar{1}\bar{2}2)$; D. (211) ; E. (110)

四、简答题 (18分)

1. 晶胞选取应满足什么条件？

答：晶胞选取应满足下列条件：晶胞几何形状充分反映点阵对称性；平行六面体内相等的棱和角数目最多；当棱间成直角时，直角数目最多；满足上面条件，晶胞体积最小。

2. 试以能带论的观点来划分导体，半导体和绝缘体。

答：能带论指出，能带中满带中电子不能导电，不满带中的电子才导电。导体的能带中一定有不满的带；绝缘体的能带中不是满带就是空带；半导体中有杂质原子存在时，导致满带缺少一些电子，原空带中也有少数电子，无杂质的半导体的满带与空带之间的禁带一般比绝缘体的小，少数电子会由满带热激发到空带底，可以导电。

3. 能带函数 $E(\mathbf{k})$ 有哪些对称性？并简述理由。

答：

五、计算题(24分)

1. 由 N 个原子组成的二维(面积为 S)简单晶格晶体，设格波的平均传播速度为 c ，应用 Debye 模型分别计算：(1)晶格振动的模式密度 $g(\omega)$ ；(2)截止频率 ω_m ；(3) Debye 温度 Θ_D ；(4)晶格的零点能 E_0 (用 N 和 ω_m 表示)。

2. 铝具有面心立方结构，有3个自由电子，点阵常数 $a=4.041$ 埃，求铝在绝对零度下的费米能，费米速度、费米温度以及单位体积的电子气平均能。

解答：1.

$$(1) \text{二维: } q \text{ 空间密度为 } \frac{S}{4\pi^2}$$

$$\text{纵波 } dq \text{ 内振动模式数} = \frac{S}{4\pi^2} 2\pi q dq$$

$$\text{纵波 } d\omega \text{ 内振动模式数 } dn = \frac{S}{4\pi^2} 2\pi \frac{\omega}{c} \frac{d\omega}{c} = \frac{S\omega}{2\pi c^2} d\omega$$

$$\text{类似地, 横波 } d\omega \text{ 内振动模式数 } dn = \frac{S\omega}{2\pi c^2} d\omega$$

$$\text{振动模式密度 } g(\omega) = \frac{dn}{d\omega} = \frac{S\omega}{\pi c^2}$$

$$(2) \text{二维} \Rightarrow \int_0^{\omega_m} \frac{S\omega}{\pi c^2} d\omega = 2N \Rightarrow \omega_m = \left(\frac{4N\pi}{S} \right)^{1/2} c$$

$$(3) \text{二维} \Theta_D = \frac{\hbar}{k_B} \left(\frac{4N\pi}{S} \right)^{1/2} c$$

$$(4) \text{频率为 } \omega \text{ 的格波的零点能为 } \frac{1}{2} \hbar \omega$$

$$\Rightarrow \text{晶体总的零点能 } E_0 = \int_0^{\omega_m} \frac{1}{2} \hbar \omega g(\omega) d\omega$$

$$\text{二维 } E_0 = \int_0^{\omega_m} \frac{1}{2} \hbar \omega \frac{S\omega}{\pi c^2} d\omega = \frac{S\hbar\omega_m^3}{6\pi c^2} = \frac{2N\hbar\omega_m}{3} (\because \omega_m^2 = \frac{4N\pi c^2}{S})$$

解答：2.

Al具有面心立方结构，每个晶胞有4个原子，每个Al原子有3个自由电子，故

$$\text{自由电子密度 } n = \frac{N}{V} = \frac{3 \times 4}{(4.041 \times 10^{-10})^3} \approx 1.819 \times 10^{29} (\text{m}^{-3})$$

$$\text{绝对零度下的费米能 } E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \approx 1.87 \times 10^{-18} (\text{J}) \approx 11.7 (\text{eV})$$

$$\frac{1}{2} m v_F^2 = E_F^0 \Rightarrow \text{费米速度 } v_F^0 = 2.32 \times 10^6 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$\text{费米温度 } T_F^0 = \frac{E_F^0}{k_B} \approx 135746 (\text{K})$$

$$\text{每个电子的平均能 } \bar{E}_0 = \frac{3}{5} E_F^0$$

$$\Rightarrow \text{单位体积电子气平均能 } \bar{E} = \frac{3}{5} n E_F^0 \approx 2.04 \times 10^{11} (\text{J} \cdot \text{m}^{-3})$$